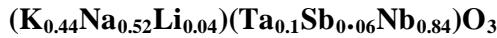


اثر روش سنتز بر میکروساختار و خواص دی الکتریک پیزوسرامیک بدون سرب



محمدعلی بهرهور^{۱*}، مهدی دلشاد چرمهینی^۱، محمدرضا رحیمی پور^۱، هومان شکرالهی^۲

^۱پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

^۲دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۰۶/۰۳/۱۳۹۲ تاریخ پذیرش قطعی: ۰۹/۰۴/۱۳۹۲

چکیده در این تحقیق پودرهای پیزوسرامیکی بدون سرب ($K_{0.44}Na_{0.52}Li_{0.04})(Ta_{0.1}Sb_{0.06}Nb_{0.84})O_3$) به دو روش سرامیکی سنتی و پوشش دهی کلوییدی آبی تهیه گردیدند. پودرهای سرامیکی سنتز شده پس از پرس شدن در دماهای مختلف پخت شدند. بر روی تمامی نمونه‌ها آزمون‌های اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روشی (SEM) و اندازه‌گیری خواص دی الکتریکی انجام شد. الگوی پراش اشعه ایکس نمونه‌های بالک ساخته شده از پودرهایی که با روش کلوییدی آبی سنتز شده بودند، تشکیل فاز خالص پروسکایت پیزوسرامیک بر پایه نایوبات سدیم-پتانسیم را نشان داد. آزمون اشعه ایکس نمونه‌های پخت شده که پودرهای اولیه آن با کمک روش سرامیکی سنتی تهیه شده از هر دو روش سرامیکی و کلوییدی آبی مورفلوژی مکعبی شکل دانه‌های نایوبات سدیم پتانسیم را بهوضوح نشان داد. ضربی دی الکتریک نمونه‌های تهیه شده به کمک روش سرامیکی سنتی بالاتر از قرص‌های ساخته شده به بهی تکیکی روش کلوییدی آبی بوده در حالی که میزان اتلاف دی الکتریک برای نمونه‌های تهیه شده به روش کلوییدی آبی پایین تر بود.

کلمات کلیدی: ضربی دی الکتریک، روش کلوییدی آبی، نایوبات سدیم-پتانسیم، XRD و SEM

The Effect of Synthesis Route on the Microstructure and Dielectric Properties of Bulk $(K_{0.44}Na_{0.52}Li_{0.04})(Ta_{0.1}Sb_{0.06}Nb_{0.84})O_3$ Piezoceramics

Mohamad Ali A. Bahrevar^{1*}, Mehdi Delshad Chermahini¹, Mohamad Reza Rahimipour¹ and Homan Shokrollahi²

¹ Materials and Energy Research Center, Department of Semiconductor Materials and Energy Research Center, Karaj, Iran

² Shiraz University of Technology, Department of Electroceramic, Shiraz Shiraz University of Technology Shiraz, Iran

Abstract Lead free piezoceramics of the $(K_{0.44}Na_{0.52}Li_{0.04})(Ta_{0.1}Sb_{0.06}Nb_{0.84})O_3$ specimens were prepared using the conventional ceramic and aqueous colloidal coating approach. The microstructure and dielectric properties of sintered samples prepared by both techniques were investigated for comparison. The XRD patterns indicate the formation of pure perovskite phase for samples prepared by colloidal technique. An additional impurity phase

محمدعلی بهرهور

نشانی: کرج، پژوهشگاه مواد و انرژی

تلفن: ۰۲۶۱۰۵۵۴۹۳، دورگاه: پامگار

mabahrevar@gmail.com

*عهده دار مکاتبات

نشانی: کرج، مشکن دشت، پژوهشگاه مواد و انرژی، تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۵۴۹۳، دورگاه: پامگار: mabahrevar@gmail.com

with tungsten bronze structure was detected for sampleseeramie synthesized by the conventional method. For both methods, the typical cube-like morphology of KNN-LST systems with the bimodal distribution was clearlyobviously observed. The relative permittivity and loss factor of samples synthesized by aqueous colloidal coating approach werewas higher and lower than those obtained by conventional ceramic technique, respectively.

Keywords:— Dielectric properties, Aqueous colloidal coating approach, Potassium sodium niobate, XRD, SEM.

Archive of SID

۱- مقدمه

محیط مورد نظر می‌باشد استفاده از KNN محدود می‌شود. محققین به منظور رسیدن به خواص الکتریکی مناسب به دنبال کاهش دمای PPT به محدوده دمای محیط می‌باشند. یک راهکار برای این قضیه افزودن همزمان لیتیوم، آتنیوم و تانتالیوم به ساختار KNN می‌باشد [۸]. یکی از مهم‌ترین ترکیباتی که پدیده PPT در دمای محیط از خود نشان داده است $(\text{K}_{0.44}\text{Na}_{0.52}\text{Li}_{0.04})\text{(Ta}_{0.1}\text{Sb}_{0.06}\text{Nb}_{0.84})_{\text{O}_3}$ می‌باشد که به صورت اختصار **KNN-LST-KNN-LNS** نوشته می‌شود. مهم‌ترین نکات تکنیکی که در حین پروسه سنتز و پخت پودرهای سرامیکی برپایه نایوبات سدیم-پتانسیم به منظور رسیدن به قرص‌های با کیفیت و خواص الکتریکی بالا وجود دارد دقت در عملیات مخلوط سازی اولیه و جلوگیری از تبخیر عناصر فرار موجود در سیستم (سدیم، پتانسیم و لیتیوم) طی پخت در دمای بالاتر از 100°C می‌باشد [۹]. به منظور کاهش تبخیر عناصر فرار از افزودنی‌های مانند MnO_{2} و CuO استفاده می‌شود که با تشکیل فاز مذاب باعث کاهش دمای پخت و در نتیجه کاهش تبخیر عناصر فرار می‌شوند. برای بهبود عملیات مخلوط سازی می‌توان روش سنتز را اصلاح کرد. در این پژوهه پودرهای پیزوسرامیکی بدون سرب سرامیکی سنتز و پوشش دهی کلریدی آبی تهیه شدند که: عملیات مخلوط سازی در این دو روش کاملاً متفاوت می‌باشد. بنابراین بررسی‌های میکرو‌ساختاری و اندازه‌گیری‌های خواص دی‌الکتریکی نمونه‌های تهیه شده می‌تواند راهگشای رسیدن به نمونه‌های پیزوسرامیکی با کیفیت و خواص مطلوب باشد. علاوه براین، بررسی وقوع پدیده PPT و تاثیر آن بر خواص دی‌الکتریکی ماده می‌تواند به سایر محققین کمک نماید. در مقایسه با کارهای انجام شده [۱۰] در گذشته روش کلریدی آبی-که قبل از کار گرفته شده، برای سنتز پیزوسرامیک **KNN-LST-KNN-LNS** مورد استفاده قرار گرفت.

۲- نحوه آزمایش و تحقیق

پودرهای اولیه Nb_2O_5 ، Sb_2O_3 ، Ta_2O_5 ، Na_2Co_3 ، K_2Co_3 و Li_2Co_3 تهیه شده از کمپانی الدریج با خلوص بالا، به منظور سنتز پودر پیزوسرامیک برپایه نایوبات

مواد فروالکتریک بر پایه سرب به دلیل برخورداری از خواص الکترومکانیکی و پیزوالکتریکی فوق العاده، کاربردهای فراوانی در زمینه صنایع الکترونیک و مهندسی به عنوان مثال سنسورها و مبدل‌ها دارند [۱]. با این وجود به دلیل سمی بودن سرب تحقیقات بسیاری بر روی مواد پیزوسرامیکی بدون سرب در سراسر جهان در حال انجام می‌باشد [۲]. در بین سرامیک‌های سازگار با محیط زیست دو گروه تیتانات بیسموت-سدیم-پتانسیم $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{1-x}\text{K}_x)\text{TiO}_3$ [۳] که به صورت اختصار BNKT نوشته می‌شود) و نایوبات سدیم-پتانسیم $\text{K}_x\text{Na}_{1-x}\text{NbO}_3$ [۴] که به طور مختصر KNN نوشته می‌شود) بهعلت دارا بودن خواص الکترومکانیکی و پیزوسرامیکی قابل رقابت با فروالکتریک‌های برپایه سرب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. مورد اخیر که محلول جامدی از نایوبات پتانسیم (یک ماده فروالکتریک) با ساختار پروسکایت ارتورومبیک و نایوبات سدیم (یک ماده آنتی فروالکتریک) با ساختار ارتورومبیک می‌باشد دارای خواص فروالکتریک مناسبی است [۵]. با افزودن ۲٪ مولی پتانسیم به فاز پروسکایت نایوبات سدیم محلول جامد حاصل از نظر ساختار تقارنی کریستالی و خواص فروالکتریکی مشابه فاز نایوبات پتانسیم می‌شود. در دمای محیط KNN با نسبت سدیم به پتانسیم برابر دارای ساختار ارتورومبیک با گروه تقارنی $\text{Amm}2$ می‌باشد. با افزایش دما تا حدود 220°C ساختار پروسکایت ارتورومبیک طی یک استحالة فازی به پروسکایت تتراگونال با تقارن فضایی $\text{P}4\text{mm}$ تبدیل می‌شود [۶]. این گروه تقارنی هم دارای خاصیت فروالکتریک می‌باشد. چنانچه ماده در محدوده دمای استحالة قرار گیرد به طوری که همزمان دارای دو ساختار فروالکتریک پروسکایت تتراگونال و ارتورومبیک باشد، پدیده حاصل را استحالة فازی پلیمورفیک (polymorphic phase transition) یا به صورت همزمان دو ساختار فروالکتریک خواص پیزوالکتریکی و فروالکتریکی ماده به شدت بهبود می‌یابد [۷]. از آنجایی که دمای PPT برای پیزوسرامیک KNN بالاتر از دمای محیط بوده می‌باشد و با توجه به این نکته که در بیشتر مواقع کاربردهای در دمای

این مشکل از دولایپیکس (CE64) به عنوان پایدارکننده استفاده شد. به منظور تهیه هر ترکیب میزان مورد نیاز از کربنات سدیم، پتاسیم و لیتیوم به صورت جداگانه در آب دیونیزه شامل ۱٪ وزنی دولایپیکس (64 CE) اضافه گردیده شد و با کمک همزن مغناطیسی به مدت یک ساعت حل شدند. محلول‌های شفاف حاصل از مرحله قبل به یک بشر ریخته شده و به مدت ۵ دقیقه تحت عملیات همزدن مغناطیسی قرار گرفت. پس از آن پودرهای اکسیدی Nb_2O_5 ، Sb_2O_3 و Ta_2O_5 به ترتیب به محلول شفاف در حال هم خوردن مرحله قبل اضافه شد و به مدت ۲۰ دقیقه مخلوط گردیده شد. سپس این محلول شیری رنگ حاصل ۲۰ دقیقه تحت عملیات التراسونیک قرار گرفت و در پایان تخلیق شد. به منظور مخلوط شدن کامل ذرات اکسیدی در محلول نمک به مدت ۹۰ ثانیه و در دو مرحله ۴۵ ثانیه‌ای تحت عملیات سونیکت با کمک دستگاه Misonix Sonicator S-4000 ultrasonic processor (50 W, 20 kHz) قرار گرفت. بالاگه بعد از عملیات سونیکت محلول حاصل در آون با دمای 180°C به مدت ۱۰ ساعت برای خشک شدن و تشکیل پوشش کلوبیدی قرار گرفت. مدد شد. محصول مرحله قبل با کمک هاون عقیق خرد شد و آماده ستیر شد. مانند روش سرامیکی سنتی پودرهای مرحله ۲ قبل به مدت ۳ ساعت در دمای 800°C جهت بتقطیر ستیر پودر فروآکتریک KNN-LSTKNL-NTS کلسینه شدند.

در این مرحله پودر کلسینه شده در محیط آب دیونیزه با نسبت وزنی کلوله به پودر ۱۰:۱ و دور 180 rpm به منظور خرد شدن اگلومرمهای ناشی از فرایند کلسیناسیون آسیاب شدند. دوغاب حاصل خشک شد و با کمک هاون عقیق خرد شده، سپس پودر حاصل از الک با مش ۴۵ عبور داده شد. با استفاده از محلول حاوی $\text{PVA} / 2\%$ به عنوان بایندر گرانول شدند. پس از آن پیوندهای خام به صورت فرشاهایی با قطر 13 mm و ضخامت 1 mm توسط پرس تک محوره با فشار 150 Mpa تهیه شد و در پایان نمونه‌ها در دماهای مختلف بین 110°C و 1140°C به مدت یک ساعت پخت شدند. دانسیته نمونه‌های تهیه شده با کمک روش ارشمیدس اندازه‌گیری گردیده شد. جهت بتقطیر بررسی مای فازی، میکروساختاری و مورفولوژیکی بر روی پودرهای کلسینه شده و نمونه‌های سیتر شده آنالیز XRD و SEM انجام شد.

سدیم - پتاسیم دوب شده با انتیموان، لیتیم و تانتالیوم به روش پوشش دهی کلوبیدی آبی استفاده شدند. برای ستر پودر پیزوسرامیک KNN-LSTKNN-LNS از دو روش سرامیکی سنتی و پوشش دهی کلوبیدی آبی استفاده شد که جزئیات هر روش به صورت زیر می‌باشد.

روش سرامیکی:

در ابتدا پودرهای مواد اولیه به خاطر این که جاذب رطوبت هوا هستند، در آون به مدت ۱۰ ساعت در دمای 100°C به منظور خشک شدمودن پرده حرارت داده شدند و در توزین پودرهای مواد اولیه دقت لازم به عمل آمد. سپس پودرهای به منظور رسیدن به استوکومتری مورد نیاز و جلوگیری از جذب مجدد رطوبت (که می‌تواند باعث بروز خطأ در محاسبات شود) سریعاً وزن شدند. پودرهای مواد اولیه بعد از توزین در محیط اتانول با کمک آسیاب سیارهای به منظور مخلوط شدن به مدت ۶ ساعت با نسبت وزنی گلوله به پودر پنج به یک و سرعت 120 rpm آسیاب می‌شوند. پس از خشک شدن دوغاب حاصل، پودرهای حاصل به مدت ۳ ساعت در دمای 100°C به منظور ستیر پودر فروآکتریک KNN-LSTKNL-NTS کلسینه شدند.

روش پوشش دهی کلوبیدی آبی:

در این روش نیز خشک کردن و توزین پودرها مانند روش سنتی می‌باشد. از آنجایی که پودرهای اولیه کربنات سدیم، پتاسیم و لیتیوم در محیط آب دیونیزه قابلیت حل شدن کامل دارند، روش پوشش دهی کلوبیدی آبی می‌تواند برای تولید این دسته از مواد بررسی شود. این روش شامل حل شدن ذرات نمک در آب و سپس توزیع ذرات اکسیدی در محلول حاصل می‌باشد. پس از آن با تبخير آب حاصل در اثر حرارت دادن در آون پوششی کلوبیدی، از ذرات ریز نمک حل شده بر روی پودرهای اکسیدی تشکیل می‌شود که می‌تواند به مخلوط شدن موثر نست به روش مخلوط کردن معمول متنه شود. نتیجه این امر به تشکیل فاز همگن فروآکتریک نایوبات سدیم - پتاسیم کمک می‌کند، اما مشکل این روش عدم توزیع مناسب ذرات اکسیدی Nb_2O_5 ، Sb_2O_3 و Ta_2O_5 در محیط آب دیونیزه در مقایسه با اتانول می‌باشد. برای رفع

بر پایه نایوبات سدیم-پتاسیم می‌باشد [۱۱] به وضوح دیده می‌شود. اندازه دانه‌ها در روش پوشش‌دهی کلوییدی آبی ریزتر از روش سنتی سرامیکی می‌باشد. اندازه دانه می‌تواند خواص دی‌الکتریک، پیزوالکتریک و فروالکتریک نمونه حاصل را تحت تاثیر قرار دهد.

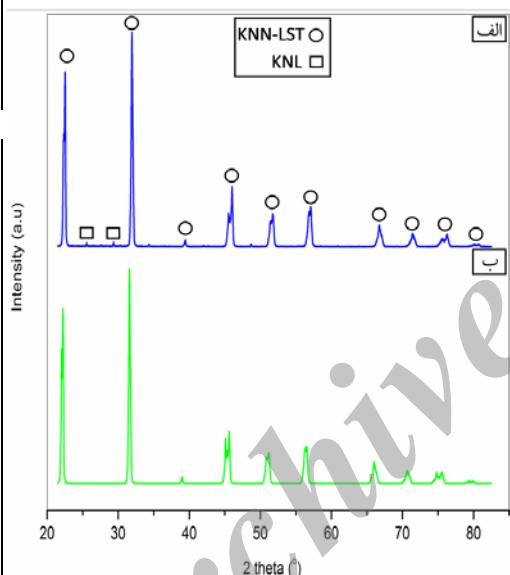
سطحهای تهیه شده از مراحل قبل توسط چسب نقره پوشیده شدند و در دمای 600°C به مدت ۱۵ دقیقه جهت خشک شدن چسب نقره حرارت داده شدند. در پایان اندازه گیری‌های خواص دی‌الکتریک با کمک دستگاه HP4291 (impedance analyzer (Agilent, Palo Alto, CA) صورت گرفت. انجام شد.

۲-۳ بررسی فازی و ساختاری

در شکل (۲) الگوی تفرق اشعه ایکس (XRD) مربوط به نمونه پیزوالکتریک KNN-LST سنتز شده به کمک روش سنتی و پوشش‌دهی کلوییدی آبی سینتیز شده در دمای 1130°C به مدت ۱۵ ساعت مشاهده می‌شود.

۳- نتایج و بحث

۱-۳ بررسی ریزساختاری و مورفولوژی



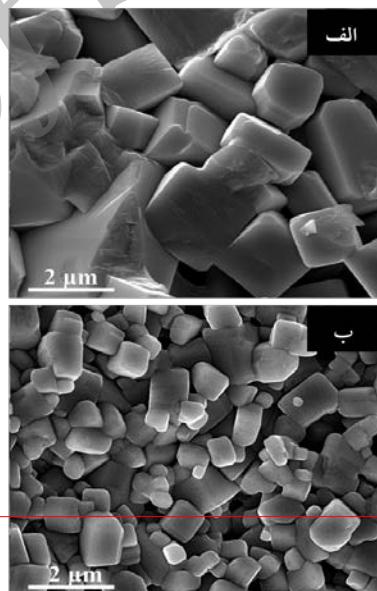
شکل ۲. نمودار XRD نمونه پیزوالکتریک KNN-LST پخت شده در دمای 1130°C از پودر سنتز شده به روش (الف) سنتی سرامیکی، (ب) پوشش‌دهی کلوییدی.

همان‌طوری‌که همان‌طوری‌که در شکل (۲) دیده می‌شود

نمونه سنتز شده با کمک روش پوشش‌دهی کلوییدی آبی حضور ساختار پروسکایت برپایه نایوبات سدیم-پتاسیم با شماره کارت مرجع ۰۱-۰۷۱-۰۹۴۸ را به صورت تکفاز نشان می‌دهند و در محدوده دقت آنالیز XRD اثری از تشکیل فاز دوم ناخالصی مشاهده نمی‌شود. عدم مشاهده فاز دوم دلالت بر نفوذ کامل لیتیوم، تانتالیوم و آنتیموان در شبکه پایه KNN

۱-۳ تصویر میکروسکوپ الکترونی روشی

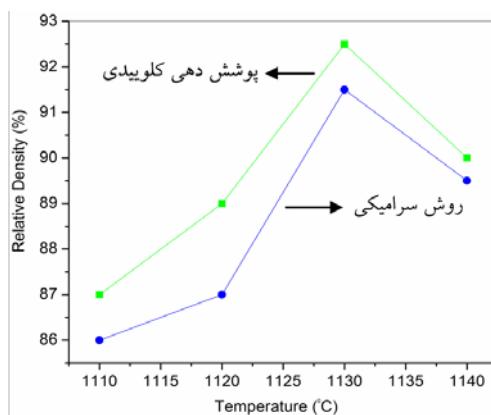
شکل (۱) مربوط به نمونه پیزوالکتریک KNN-LST سنتز شده به کمک روش سنتی و پوشش‌دهی کلوییدی آبی سینتیز شده در دمای 1130°C به مدت ۱۵ ساعت را نشان می‌دهد.



شکل ۱. تصاویر SEM نمونه پیزوالکتریک KNN-LST پخت شده در دمای 1130°C از پودر سنتز شده به روش (الف) سنتی سرامیکی، (ب) پوشش‌دهی کلوییدی.

همان‌طوری‌که همان‌طوری‌که در شکل (۱) مشاهده می‌شود برای هر دو روش نمونه‌های پیزوسرامیک با ساختار فشرده و مورفولوژی مکعبی دانه‌ها که از مشخصه‌های پیزوسرامیک‌های

$^{\circ}\text{C}$ ۱۱۳۰ می‌تواند به دلیل تبخر اجزای فرار موجود در سیستم از جمله Na، K و Li در دماهای بالا باشد [۱۲]. علاوه بر این مقادیر دانسیته در تمامی دماهای پخت برای روش پوشش دهی کلوییدی آبی بالاتر می‌باشد.



شکل ۳. نمودار دانسیته نسبی نمونه‌های پیزوالکتریک KNN-LST بر حسب دمای پخت

از آنجایی که اندازه دانه می‌تواند خواص دیالکتریک، پیزوالکتریک و فروالکتریک نمونه حاصل را تحت تاثیر قرار دهد، انتظار می‌رود که نمونه‌های تهیه شده به کمک روش پوشش دهی کلوییدی آبی نسبت به روش سرامیکی سنتی، خواص دیالکتریک مناسب‌تری دارا باشند.

۴-۳ بررسی خواص دیالکتریکی

در جدول ۱ مقادیر ضریب دیالکتریک و فاکتور اتلاف مربوط به نمونه‌های پیزوسرامیک KNN-LST سنتر شده به کمک روش پوشش دهی کلوییدی آبی و سرامیکی سنتی، پخت شده در دماهای $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۳۰ و $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۴۰ به مدت ۱ ساعت ارایه شده است.

جدول ۱. مقادیر ضریب دیالکتریک و فاکتور اتلاف در فرکانس ۱ kHz برای نمونه‌های پیزوالکتریک KNN-LST سنتر شده به روش کلوییدی آبی و سنتی سرامیکی پخت شده در دماهای مختلف.

فاکتور اتلاف	ضریب دیالکتریک	نمونه
۰/۰۲۹	۱۷۶۰	روش کلوییدی، دمای پخت $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۳۰
۰/۰۰۸	۱۳۹۵	روش کلوییدی، دمای پخت $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۴۰

و تشکیل فاز KNN-LST دارد. بنابر نتایج حاصل از الگوی تفرق اشعه ایکس نمونه‌ها مشاهده می‌شود^{شود} که عملیات پخت با موفقیت انجام شده و فاز دوم در حین این عملیات تشکیل نشده است. در نمودار XRD نمونه سنتر شده به روش سرامیکی سنتی علاوه بر ساختار پروسکایت، پیک-های مربوط به فاز دوم $\text{LiNb}_6\text{O}_{17}$ (که به صورت اختصار KLN نوشته می‌شود) در زوایای بین 25° تا 30° مشاهده دیده شدن. ژو و همکارانش [۱۲] نشان دادند که یکی از فازهای ناخالصی که معمولاً در حین پخت نمونه‌های فروالکتریک بر پایه نایوبات سدیم-پتانسیم تشکیل می‌شود فاز KLN با شماره کارت ۰۵۳۳-۳۶ و ساختار کریستالوگرافی موسوم به تنگستن-برنز تتراگونال (TTB) می‌باشد. این فاز یک اکسید شفاف با دمای انتقال فروالکتریک-پارالکتریک حدود $^{\circ}\text{C}$ ۴۲۰ است که تشکیل آن این فاز می‌تواند خواص دیالکتریک، پیزوالکتریک و فروالکتریک نمونه حاصل را تحت تاثیر قرار دهد. فاز KLN در اثر تبخر اجزای فرار موجود در سیستم از جمله Na، K و Li تشکیل می‌شود. هرچند میزان تبخر این اجزای در دماهای مختلف متفاوت گارش شده است [۱۳]، در تمامی دماهای بالاتر از $^{\circ}\text{C}$ ۱۰۰۰ میزان تبخر سدیم به مرأت بالاتر از پتانسیم و لیتیوم می‌باشد. بنابراین عدم منطقی که از سدیم فقیر باشد احتمال تشکیل فاز دوم KLN وجود دارد. با کنترل مناسب پروسه پخت و همچنین مخلوط سازی مطلوب می‌توان از تشکیل این فاز جلوگیری کرد. بنابراین عدم تشکیل این فاز در روش پوشش دهی کلوییدی آبی دلالت بر مخلوط سازی موثرتر در این روش نسبت به روش سنتی سرامیکی دارد.

۴-۴ بررسی دانسیته نسبی

در شکل ۲ دانسیته نسبی مربوط به نمونه‌های پیزوسرامیک KNL-NTS سنتر شده به کمک روش سرامیکی سنتی و پوشش دهی کلوییدی آبی بر حسب دمای پخت ارایه شده است. همان‌طوری که در شکل ۲ می‌بینیم برای هر دو روش با افزایش دمای پخت از $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۱۰ تا $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۳۰، دانسیته نمونه‌ها افزایش می‌یابد و سپس با افزایش دما تا $^{\circ}\text{C}$ ۱۱۴۰ میزان دانسیته کاهش می‌یابد. کاهش مقادیر دانسیته نسبی نمونه‌های پیزوالکتریک KNN-LST در دمای بالاتر از

سدیم- پتاسیم را به صورت تکفاز نشان می‌دهد. در نمونه سنتز شده به روش سرامیکی سنتی و سپس پخت شده علاوه بر ساختار پروسکایت، پیک‌های مریبوط به فاز دوم $K_3LiNb_6O_{17}$ نیز مشاهده شد. برای هر دو روش با افزایش دمای پخت از 1110°C تا 1140°C دانسیته نمونه‌ها افزایش یافته می‌باشد و سپس با افزایش بیشتر دما تا 1140°C میزان دانسیته کاهش می‌یابد.

علاوه بر این مقادیر دانسیته در تمامی دماهای پخت برای روش پوشش‌دهی کلوییدی آبی بالاتر می‌باشد. مقادیر ضریب $\frac{d\epsilon}{dT}$ الکتریک برای نمونه سنتز شده به کمک روش پوشش‌دهی کلوییدی نسبت به روش فاکتور اتلاف پایین‌تر می‌باشد.

		پخت 1140°C
روش سنتی، دمای 1130°C	۰/۰۳۵	۱۶۵۰
پخت 1130°C	۰/۰۹	۱۲۰۰
روش سنتی، دمای 1140°C		

متانظریک- همانظریک مشاهده می‌شود مقادیر ضریب $\frac{d\epsilon}{dT}$ الکتریک در هر دو دمای پخت برای نمونه سنتز شده به کمک روش پوشش‌دهی کلوییدی نسبت به روش سرامیکی بالاتر می‌باشد. همان‌گونه که در قسمت‌های قبل ذکر شد عواملی چون تشکیل فاز دوم ناخالصی و دانسیته نمونه‌ها می‌تواند بر خواص دی‌الکتریک تاثیر گذارد [۵۵] و [۵۶]. بنابراین این بالاتر بودن ضریب دی‌الکتریک نمونه سنتز شده به روش پوشش‌دهی کلوییدی نسبت به روش سرامیکی می‌تواند به دلیل عدم تشکیل فاز KLN و همچنین بالاتر بودن دانسیته نمونه‌های تهیه شده با کمک روش پوشش‌دهی کلوییدی باشد. از طرف دیگر فاکتور اتلاف برای نمونه‌های تهیه شده به هر دو روش تقریباً یکسان می‌باشد. علاوه بر این در هر دو روش سنتز با افزایش دمای پخت از 1130°C به 1140°C مقادیر ضریب دی‌الکتریک کاهش یافته و فاکتور اتلاف نمونه‌های افزایش می‌یابد. ضریب دی‌الکتریک برای پیزوسرامیک KNN-LST در بازه 1570°C تا 1750°C گزارش شده است [۱۰، ۱۱]. مقادیر ضریب دی‌الکتریک در تحقیق حاضر برای روش پوشش‌دهی کلوییدی آبی 1760°C گزارش شده که نشان‌دهنده موقوفیت آمیز بودن روش مذکور در تولید پیزوسرامیک KNN-LST KNN-LST می‌باشد.

نتیجه گیری

- Hollenstein, E., E., Damjanovic, D., D., Setter, N., N., Temperature stability of the piezoelectric properties of Li-modified KNN ceramics, *Journal of the European Ceramic Society*, 2007, 27, 4093-4097.
- Bomlai, P., P., Muensit, N., N., Structural and electrical properties of $\text{Na}_{0.47}\text{K}_{0.47}\text{Li}_{0.06}\text{NbO}_3$ lead-free piezoelectric ceramics modified by AgSbO_3 , *Ceramic International*, 2013, 39, S135-S138.
- Mosavi, A., A., Bahrevar, M.A., M. A., Aghaei, A.R., A.R., Ramos, High-field electromechanical response of $\text{Bi}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{TiO}_3$ - $\text{Bi}_{0.5}\text{K}_{0.5}\text{TiO}_3$ across its morphotropic phase boundary, *Journal of Physics D: Applied Physics*, 47, 055304, doi:10.1088/0022-3727/47/5/055304.
- Bernard, J., J., Wan, A., A., B., Rojac, T., T., Low-temperature sintering of $\text{K}_{0.5}\text{Na}_{0.5}\text{NbO}_3$ ceramics, *Journal of the American Ceramic Society*, 2008, 91, 2409-2411.
- Zhengfa, L., L., Yongxiang, L., L., Jiwei, Z., Z., Grain growth and piezoelectric property of KNN-based lead-free ceramics, *Current Applied Physics*, 2011, 11, S2-S13.
- Feng, J., J., Li, J., Li., Wang, K., K., Zhu, F., F., Cheng, L., L., (K, Na)NbO₃-Based Lead-Free Piezoceramics: Fundamental aspects, processing technologies, and remaining challenges, *Journal of the American Ceramic Society*, 2013, 96, 3677-3696.
- Wada, S., S., Yamashita, K., Enhanced piezoelectric properties of barium titanate-potassium niobate nanostructured ceramics by MPB engineering, *Ceramic International*, 2013, 39, S97-S102.
- Wada, S., S., Yamashita, K., Enhanced piezoelectric properties of barium titanate-potassium niobate nanostructured ceramics by MPB engineering, *Ceramic International*, 2013, 39, S97-S102.
- Li, W., Xu, Z., L.W., Chu, Z., R., R., Zeng, H., H., Enlarged polymorphic phase transition boundary and enhanced piezoelectricity in ternary component $0.8\text{Ba}_{1-x}\text{Ca}_x\text{TiO}_3-0.1\text{BaTi}_{0.8}\text{Zr}_{0.2}\text{O}_3$

- 0.1BaTi_{0.9}Sn_{0.1}O₃ ceramics”, *Materials Letters*, 2013, 110, 80-82.
9. Wongsaenmai, S., S., Ananta, S., S., Yimnirun, R., R., “Effect of Li addition on phase formation behavior and electrical properties of (K_{0.5}Na_{0.5})NbO₃ lead free ceramics”, *Ceramic International*, 2012, 39, 147-152.
10. Hagh, N. M., N.M., Kerman, K., K., Safari, A., A., “Dielectric and piezoelectric properties of Cu²⁺-doped alkali niobates”, *Journal of the European Ceramic Society*, 2009, 29, 2325-2332.
11. Mgbemere, H. E., H.E., Herber, R.P., R. P., Gerold, A.S., A. S., “Effect of MnO₂ on the dielectric and piezoelectric properties of alkaline niobate based lead free piezoelectric ceramics”, *Journal of the European Ceramic Society*, 2009, 29, 1729-1733.
12. Qian, S., S., Kongjun, Z., Z., Pang, X., X., “Phase transition, microstructure and dielectric properties of Li/Ta/Sbco-doped(K.Na)NbO₃ lead-free ceramics”, *Ceramics International*, 2014, 40, 4389-4394.
13. Wang, K., K., (K., Na)NbO₃-based lead-free piezoceramics: Phase transition, sintering and property enhancement”, *Journal of Advanced Ceramics*, 2012, 1(1) 24-37.
14. Saito, Y., Y., Takao, H., H., Tani, T., T., Nonoyama, T., T., Takatori, K., K., Homma, T., T., Nagaya, T., T., Nakamura, M., M., “Lead-free piezoceramics”, *Nature*. 2004, 432 84-87.